2P081

アークプラズマ蒸着法を用いた金属ナノ粒子担持 配位高分子の作製

(九大 WPI-I2CNER¹, JST-CREST², 九大理³, 理研 RSC⁴) ○貞清 正彰^{1,2}, 吉丸 翔太郎³, 笠井 秀隆^{2,4}, 加藤 健一^{2,4}, 高田 昌樹⁴, 山内 美穂^{1,2,3}

Preparation of metal nanoparticles supported on metal–organic frameworks through arc plasma deposition

(WPI-I2CNER, Kyushu Univ.¹; JST-CREST²; Fac. Sci., Kyushu Univ.³; RIKEN SPring-8 Center⁴) OMasaaki Sadakiyo^{1,2}, Shotaro Yoshimaru³, Hidetaka Kasai^{2,4}, Kenichi Kato^{2,4}, Masaki Takata⁴, Miho Yamauchi^{1,2,3}

【序論】高い比表面積と構造の多様性を有する配位高分子は、触媒担体として優れた特性を 示すと期待され、近年、溶液中での化学還元等により金属ナノ粒子を担持した多様な配位高 分子の作製が報告されている。我々は、金属ナノ粒子担持配位高分子を大量かつ簡便に作製 する新たな手法として、アークプラズマ蒸着(APD)法に着目する。本研究では、APD 法を用 いて様々な配位高分子への種々の金属(Ru, Pd, Pt)粒子の担持を試み、配位高分子および担持金 属による複合体構造の変化について系統的な検討を行った。

【実験】約2~5gの配位高分子(ZIF-8,¹ MIL-101,² MOF-74³)粉末を真空下で攪拌しながら、各種金属ターゲット(Ru, Pd, Pt)から数万回のアークプラズマ照射を行った。得られた試料を用いて透過型電子顕微鏡(TEM)観察、走査透過型電子顕微鏡(STEM)観察、STEM-EDS分析、粉末X線回折(XRPD)測定、および吸着等温線測定を行い、作製した複合体の構造を調べた。



【結果と考察】図1に各種金属がZIF-8に担持された試料(M/ZIF-8; M = Ru (2.9 wt%), Pd (1.8

図 1. (左) Ru/ZIF-8, (中央) Pd/ZIF-8, (右) Pt/ZIF-8の TEM または STEM 像および粒径分散.

wt%), Pt (2.4 wt%))の TEM 像を示す。アークプラズマ 照射により直径 2 nm 程度(1.9 ± 0.5 nm (Ru), 2.3 ± 0.4 nm (Pt), 2.4 ± 0.6 nm (Pd))の粒子状の金属が ZIF-8 結晶上に均一に分散して存在することがわかった。図 2に Ru/ZIF-8の STEM-EDS マッピング像を示す。測定 の結果、担持された Ruは、Znを含む錯体である ZIF-8 の結晶上に広く分布しているが、そのEDS 強度分布(図 2 下) は、ZIF-8 の結晶の形状を反映した Zn-K の分布 とは全く異なることが分かった。このことから、Ruナ ノ粒子は ZIF-8 の結晶内部に均一に存在するのではな く、結晶外部に担持されていることが示唆された。 XRPD 測定の結果(図3)、全ての試料において、アー クプラズマ照射後も ZIF-8 の骨格構造が保持されてい ることが分かった。さらに、77Kにおける窒素吸着等 温線測定の結果(図4)、アークプラズマ照射前のZIF-8 とほぼ同等の窒素吸着量を示したことから、照射後も 担体の細孔構造が保持されていることがわかった。ま た、他の担体である MIL-101 および MOF-74 に約3 wt% のRuを担持した試料においても、ZIF-8を用いた場合 と同様に、約2 nmのRuナノ粒子が MOF 結晶上に担 持されることがわかった。以上より、APD 法により金



図 2. (上) Ru/ZIF-8 の STEM-EDS マップピング像(緑: Ru-K,赤: Zn-K)および (下) 上図矢印方向 の EDS 強度分布.

属種やMOFの種類によらず、ほぼ同一の粒径および分散性をもつ金属ナノ粒子担持配位高分子が作製されることが明らかとなった。

(参考文献) (1) O. M. Yaghi, et al. *PNAS* **2006**, *103*, 10186. (2) G. Ferey et. al. *Science* **2005**, *309*, 2040. (3) O. M. Yaghi, et al. *J. Am. Chem. Soc.* **2005**, *127*, 1504.

